








	<p>SI3867DV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3867DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3867DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45143 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3867DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45143 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.9A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	51 mOhm @ 5.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3867DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3867DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3867DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3867DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3865DV-T1-GE3 VISHAY SI3865DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI3900DV VISHAY SI3900DV VISHAY</p>	 <p>SI3879DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3867 VISHAY</p>
 <p>SI3879DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3879DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3867DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3867DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  SI3850DV-T1-E3 |  SI3850DV-T1-GE3 |  SI3851DV |  SI3851DV-T1 |  SI3851DV-T1-E3 |
|  SI3851DV-T1-E3 |  SI3851DV-T1-GE3 |  SI3853DV-T1-E3 |  SI3853DV-T1-E3 |  SI3861BDV-T1-GE3 |
|  SI3861BDV-T1-GE3 |  SI3861DV-NL |  SI3861DV-T1-E3 |  SI3863BDV-T1-GE3 |  SI3863DV-T1-E3 |
|  SI3863DV-T1-GE3 |  SI3865BDV-T1-E3 |  SI3865BDV-T1-E3 |  SI3865CDV-T1-GE3 |  SI3865CDV-T1-GE3 |
|  SI3865DV-T1 |  SI3865DV-T1-E3 |  SI3865DV-T1-GE3 |  SI3867DV-T1-E3 |  SI3867DV-T1-E3 |
|  SI3867DV-T1-GE3 |  SI3879DV-T1-E3 |  SI3879DV-T1-E3 |  SI3900DV |  SI3900DV-T1-E3 |
|  SI3900DV-T1-E3 |  SI3900DV-T1-GE3 |  SI3900DV-T1-GE3 |  SI3905DV-T1 |  SI3905DV-T1-E3 |
|  SI3905DV-T1-E3 |  SI3905DV-T1-GE3 |  SI3905DV-T1-GE3 |  SI3909DV-T1 |  SI3909DV-T1-E3 |
|  SI3909DV-T1-E3 |  SI3909DV-T1-GE3 |  SI3909DV-T1-GE3 |  SI3911DV |  SI3911DV-T1 |
|  SI3911DV-T1-E3 |  SI3911DV-T1-E3 |  SI3911DV-T1-G33 |  SI3911DV-T1-GE3 |  SI3911DV-T3-E3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited